

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-63195

(P2008-63195A)

(43) 公開日 平成20年3月21日(2008.3.21)

(51) Int.Cl.  
C01B 37/02 (2006.01)F1  
C01B 37/02テーマコード (参考)  
4G073

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2006-244056 (P2006-244056)  
(22) 出願日 平成18年9月8日 (2006.9.8)(71) 出願人 504182255  
国立大学法人横浜国立大学  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79番1号  
(74) 代理人 100110249  
弁理士 下田 昭  
(74) 代理人 100113022  
弁理士 赤尾 謙一郎  
(74) 代理人 100102130  
弁理士 小山 尚人  
(72) 発明者 窪田 好浩  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79番1号 国立大学法人横浜国立大学内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 MCM-68のトポロジーを持つ結晶性多孔質シリケート及びその製法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】ゼオライトMCM-68のトポロジーを有し、Alを全く含まない結晶性多孔質シリケート及びその製法を提供する。

【解決手段】MCM-68製造時に用いる鋳型分子及びドライゲル法を改良することにより、ゼオライトMCM-68のトポロジーを有し、Alを含まない結晶性多孔質シリケートを合成した。組成式は $R_4Si_{112-n}O_{232-m}H_{8+4n-2m}$  (式中、 $n=0\sim 12$ 、 $m=0\sim n$ 、RはN, N, N', N'-テトラアルキルピシクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウム(但し、アルキル基は、その炭素数が4以下であり、同じであっても異なってもよい。))で表され、下記の値を含むX線回折パターンをもつ結晶性多孔質シリケートである。2 (単位:度) = 6.88 ± 0.10、8.16 ± 0.10、8.84 ± 0.10、9.72 ± 0.10、19.48 ± 0.10、21.82 ± 0.10、22.70 ± 0.10、23.24 ± 0.10。

【選択図】なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

組成式  $R_4Si_{1.12-n}O_{2.32-m}H_{8+4n-2m}$  (式中、 $n = 0 \sim 1.2$ 、 $m = 0 \sim n$ 、 $R$  は  $N$ 、 $N$ 、 $N'$ 、 $N'$ -テトラアルキルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウム(但し、アルキル基は、その炭素数が4以下であり、同じであっても異なってもよい。))で表され、下記の値を含むX線回折パターンをもつ合成したままの(as-synthesized)結晶性多孔質シリケート。

$2\theta$  (単位:度) =  $6.88 \pm 0.10$ 、 $8.16 \pm 0.10$ 、 $8.84 \pm 0.10$ 、 $9.72 \pm 0.10$ 、 $19.48 \pm 0.10$ 、 $21.82 \pm 0.10$ 、 $22.70 \pm 0.10$ 、 $23.24 \pm 0.10$ 、ただし、 $2\theta = 23.24 \pm 0.10$ のピークの半値幅は0.20度以下である。

10

## 【請求項 2】

(1)シリカ源、(2) $N$ 、 $N$ 、 $N'$ 、 $N'$ -テトラアルキルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウム(但し、アルキル基は、その炭素数が4以下であり、同じであっても異なってもよい。)の水酸化物又はハロゲン化物、(3)アルカリ金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物、及び(4)水との混合物を乾燥して、粉末状のドライゲルとするドライゲル化工程と、得られた該ドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触させた状態で反応させる重合工程とから成る製法により得られた請求項1に記載の結晶性多孔質シリケート。

## 【請求項 3】

組成式  $Si_{1.12-n}O_{2.24-m}H_{4n-2m}$  (式中、 $n = 0 \sim 1.2$ 、 $m = 0 \sim n$ )で表され、下記の値を含むX線回折パターンをもつ結晶性多孔質シリケート

$2\theta$  (単位:度) =  $6.52 \pm 0.10$ 、 $6.84 \pm 0.10$ 、 $8.12 \pm 0.10$ 、 $8.80 \pm 0.10$ 、 $9.68 \pm 0.10$ 、 $19.44 \pm 0.10$ 、 $21.76 \pm 0.10$ 、 $22.64 \pm 0.10$ 、 $23.16 \pm 0.10$ 、ただし、 $2\theta = 23.16 \pm 0.10$ のピークの半値幅は0.20度以下である。

20

## 【請求項 4】

(1)シリカ源、(2) $N$ 、 $N$ 、 $N'$ 、 $N'$ -テトラアルキルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウムジヒドロキッド(但し、アルキル基は、その炭素数が4以下であり、同じであっても異なってもよい。)、(3)アルカリ金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物、及び(4)水との混合物を乾燥して、粉末状のドライゲルとするドライゲル化工程、得られた該ドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触させた状態で反応させる重合工程、更に、シリル化剤を加えてオートクレーブ中で加熱するシリル化工程、及びこれを焼成する焼成工程から成る製法により得られた請求項3に記載の結晶性多孔質シリケート。

30

## 【請求項 5】

前記シリル化剤がテトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン又はテトラクロロシランである請求項4に記載の結晶性多孔質シリケート。

## 【請求項 6】

(1)シリカ源、(2) $N$ 、 $N$ 、 $N'$ 、 $N'$ -テトラアルキルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウムジヒドロキッド(但し、アルキル基は、その炭素数が4以下であり、同じであっても異なってもよい。)、(3)アルカリ金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物、及び(4)水との混合物を乾燥して、粉末状のドライゲルとするドライゲル化工程と、得られた該ドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触させた状態で反応させる重合工程とから成る合成したままの(as-synthesized)結晶性多孔質シリケートの製法。

40

## 【請求項 7】

請求項6に記載の製法に、更に、得られた結晶性多孔質シリケートに、シリル化剤を加えてオートクレーブ中で加熱するシリル化工程、及びこれを焼成する焼成工程を含む結晶性多孔質シリケートの製法。

## 【請求項 8】

前記シリル化剤がテトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン又はテトラクロロシラン

50

である請求項7に記載の製法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、ゼオライトMCM-68のトポロジーを有し、Alを全く含まない結晶性多孔質シリケート及びその製法に関する。

【背景技術】

【0002】

アルミノシリケートMCM-68は2000年にMobil社により合成された比較的新しいゼオライトである(特許文献1)。このゼオライトは、大細孔(12員環細孔)や中細孔(10員環細孔)が三次元的に交わった構造をもつ。このタイプのゼオライトは一般に広い表面積と大きな内部空間を持つので、石油精製や石油化学プロセスにおける触媒として有用であり、比較的嵩高い有機分子を基質とする触媒として有用と期待されている。MCM-68はSi/Al比が9~12であることから比較的Al含有量、つまり活性点が多く、さらに安定なため酸触媒として検討され、中でも、炭化水素の吸着能力が高いため、それが関与する反応、例えば芳香族炭化水素のアルキル化やアルキル芳香族炭化水素のトランスアルキル化、異性化、不均化、脱アルキル化などにおいて高い活性を示すため、炭化水素プロセッシング触媒の基盤材料として期待されている。

Mobil社によるアルミノシリケートMCM-68の製法は、鑄型(テンプレート)、コロイダルシリカ、水酸化カリウム、水酸化アルミニウム及び水を混合して得たゲルを、オートクレーブ中で加熱し、得られた結晶を焼成するといういわゆる水熱法であった。

一方、本発明者らは、既に、水熱法でなく、ゲル状に調製した原料混合物を乾燥して粉末状のドライゲルとし、得られたドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触させて反応させるドライゲル法によりアルミノシリケートを合成する方法を開発している(特許文献2)。その他、本発明者らは、各種ゼオライトを前駆体とする水熱合成によるアルミノシリケートの合成法を開発している(特許文献3)。

【0003】

【特許文献1】特表2002-535227(W000/43316)

【特許文献2】特許第3322308号

【特許文献3】特開2005-82473

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

MCM-68はSi/Al比が9~12であることから比較的Al含有量、つまり活性点が多く、さらに安定なため酸触媒として検討され、中でも、炭化水素の吸着能力が高いため、それが関与する反応、例えば芳香族炭化水素のアルキル化やアルキル芳香族炭化水素のトランスアルキル化、異性化、不均化、脱アルキル化などにおいて高い活性を示すので、炭化水素プロセッシング触媒の基盤材料として期待されている。Si/Al比が(全シリカ組成)の場合は、酸触媒としてよりもむしろ環境汚染物質である揮発性有機化合物(VOC)などの吸着剤、脱臭剤などとして有望となる。

ゼオライト合成において、Si/Al比の高い(高シリカナ)ゼオライトを得るための第一の戦略は、合成ゲル(出発ゲル)中のSi/Al比を高く設定しておくことである。しかし、MCM-68の合成においては、合成ゲル中のSi/Al比が9~12の範囲を外れると、MCM-68のトポロジーではなく、別の骨格トポロジーをもつ物質が結晶化するという問題があった。例えば合成ゲルにおいてSi/Al比が(全シリカ組成)の時にはZSM-12(MTWトポロジー)のゼオライトが結晶化する。

【0005】

本発明者らは、MCM-68のAlをTiに置き換えたチタノシリケートを合成し、オレフィンのエポキシ化に対して高い性能を示し、Alの残存量が少ないほど高性能であることを見いだしている(特願2006-226279)。しかしながら、このチタノシリケートの製法においては

、もともと Si / Al 比が 9 ~ 12 の MCM-68 から Al を除去しているため、微量とはいえ痕跡量の Al の残存を避けられない。Al を全く含まないサンプルを得るためには、Al を全く含まない出発ゲルからサンプルを結晶化させる必要がある。ところが、上述のように MCM-68 のトポロジ-をもち、Al を全く含まないシリケートを直接結晶化することは困難であり、これまで達成されていなかった。

触媒用途において必要以上の Al は、コーキング（炭素質析出）を誘発する原因となり、好ましくない。Al を全く含まないサンプルは、チタノシリケートの他にも各種高純度メタロシリケート（金属元素を骨格に含むシリケート）の合成のために必須である。

本発明は、ゼオライト MCM-68 のトポロジ-を有し、Al を全く含まない結晶性多孔質シリケート及びその製法を提供することを目的とする。ゼオライト MCM-68 のトポロジ-は、後述の表 1 に示す原子座標と結晶学的パラメーターにより一義的に決まる。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者らは、MCM-68 製造時に用いる鑄型分子を改変して用い、更に本発明者らが開発したドライゲル法（特許文献 2）を改良して、その他のドライゲル形成の条件を最適化することにより、ゼオライト MCM-68 のトポロジ-を有し、Al を全く含まない結晶性多孔質シリケートを合成することに成功した。本発明の結晶性多孔質シリケートが、原料や製法が全く異なるにもかかわらず MCM-68 トポロジ-を持つのは、用いた鑄型分子がこの MCM-68 トポロジ-の形成を強力に促進するからである。この鑄型分子の親/疎水性、サイズ、剛直性、化学的安定性などが MCM-68 トポロジ-の形成に寄与していると考えられる。

【0007】

即ち、本発明は、組成式  $R_4 Si_{112-n} O_{232-m} H_{8+4n-2m}$ （式中、 $n = 0 \sim 12$ 、 $m = 0 \sim n$ 、R は N, N, N', N'-テトラアルキルピシクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウム（但し、アルキル基は、その炭素数が 4 以下であり、同じであっても異なってもよい。）で表され、下記の値を含む X 線回折パターンをもつ合成したままの（as-synthesized）結晶性多孔質シリケートである。  
 $2\theta$ （単位：度）=  $6.88 \pm 0.10$ 、 $8.16 \pm 0.10$ 、 $8.84 \pm 0.10$ 、 $9.72 \pm 0.10$ 、 $19.48 \pm 0.10$ 、 $21.82 \pm 0.10$ 、 $22.70 \pm 0.10$ 、 $23.24 \pm 0.10$ 、ただし、 $2\theta = 23.24 \pm 0.10$  のピークの半値幅は  $0.20$  度以下である。

また本発明は、組成式  $Si_{112-n} O_{224-m} H_{4n-2m}$ （式中、 $n = 0 \sim 12$ 、 $m = 0 \sim n$ ）で表され、下記の値を含む X 線回折パターンをもつ結晶性多孔質シリケートである。

$2\theta$ （単位：度）=  $6.52 \pm 0.10$ 、 $6.84 \pm 0.10$ 、 $8.12 \pm 0.10$ 、 $8.80 \pm 0.10$ 、 $9.68 \pm 0.10$ 、 $19.44 \pm 0.10$ 、 $21.76 \pm 0.10$ 、 $22.64 \pm 0.10$ 、 $23.16 \pm 0.10$ 、ただし、 $2\theta = 23.16 \pm 0.10$  のピークの半値幅は  $0.20$  度以下である。

【0008】

更に、本発明は、(1)シリカ源、(2) N, N, N', N'-テトラアルキルピシクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウムジヒドロキッド（但し、アルキル基は、その炭素数が 4 以下であり、同じであっても異なってもよい。）、(3)アルカリ金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物、及び(4)水との混合物を乾燥して、粉末状のドライゲルとするドライゲル化工程と、得られた該ドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触させた状態で反応させる重合工程とから成る合成したままの（as-synthesized）結晶性多孔質シリケートの製法である。

また本発明は、この製法に、更に、得られた結晶性シリケートに、シリル化剤を加えてオートクレーブ中で加熱するシリル化工程、及びこれを焼成する焼成工程を含む結晶性多孔質シリケートの製法である。

【発明の効果】

【0009】

本発明の Al を全く含まない結晶性多孔質シリケートは、粉末 X 線回折のピークが鋭く

(半値幅が狭い)、結晶性が高いため、熱安定性、水熱安定性が高く、耐久性に優れた材料となりうる。欠損をSi原子で埋めれば、MCM-68トポロジ-をもち、なおかつ全シリカ組成をもつシリケートとなる。また、欠損を部分的にSi原子で埋め、残った欠損をさらに他の金属原子で埋めれば、MCM-68の骨格をもつ各種メタロシリケートが得られる。本発明はその基盤材料を与えるものである。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

本発明の結晶性多孔質シリケートは、Alを含まず、表1に示した原子座標と結晶学的パラメーターで一義的に決まるゼオライトMCM-68のトポロジ-を有する。

MCM-68は、12員環及び10員環のチャンネルが三次元的に交わった構造をもつアルミノシリケートである。ユニットセル(単位胞)は $\text{Si}_{100.6}\text{Al}_{111.4}\text{O}_{224}$ という組成の正方晶系である。MCM-68構造についてはInternational Zeolite Association Structure Commission (IZA-SC)により三文字コードはまだ与えられていないが、表1に示す原子座標で一義的に決まる骨格トポロジ-をもつ。z軸方向にまっすぐな12員環チャンネル(直径0.67 nm)、x軸及びy軸方向に2つのうねった10員環チャンネル(直径0.50-0.55 nm)が存在する。また、10員環を通ることによってのみアクセス可能な空洞(ケージ)(0.65(1.73 nm)を有する(J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 2045-2050)。

【0011】

【表1】

原子	x/a	y/b	z/c
Si1	0.1298(2)	0.7543(3)	0.1100(3)
Si2	0.1322(2)	0.7487(3)	0.2685(3)
Si3	0.0306(3)	0.2148(3)	0.0740(2)
Si4	0.1300(2)	0.2530(2)	0.1859(3)
Si5	0.0294(2)	0.2174(2)	0.3124(2)
Si6	0.0622(1)	0.0622(1)	0.1402(4)
Si7	0.0622(1)	0.0622(1)	0.2856(4)
Si8	0.1331(2)	0.2540(3)	0.4269(3)
O9	0.1199(6)	0.7447(8)	0.1892(3)
O10	0.0512(2)	0.7521(3)	0.0735(4)
O11	0.1801(5)	0.6884(6)	0.0823(6)
O12	0.1680(5)	0.8320(5)	0.0944(7)
O13	0.0532(2)	0.7530(3)	0.3043(4)
O14	0.1746(3)	0.6762(4)	0.2935(4)
O15	0.1794(5)	0.8206(5)	0.2869(8)
O16	0.0815(3)	0.2659(4)	0.1202(2)
O17	0.0641(5)	0.2161(6)	0.0
O18	0.0293(3)	0.1317(2)	0.1009(4)
O19	0.1870(3)	0.1870(3)	0.1732(6)
O20	0.0751(3)	0.2310(3)	0.2452(3)
O21	0.0283(3)	0.1303(2)	0.3264(3)
O22	0.0691(4)	0.2597(4)	0.3727(3)
O23	0.0	0.0	0.1464(5)
O24	0.0886(1)	0.0886(1)	0.2130(3)
O25	0.0	0.0	0.2785(5)
O26	0.1919(5)	0.1919(5)	0.4079(9)
O27	0.1007(8)	0.2412(9)	0.5

10

20

30

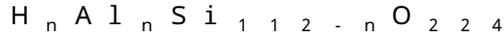
40

50

注) 空間群  $P4_2/mmm$  (International Union of Crystallography (IUCr)の定めるNo. 136の空間群) 格子定数  $a (=b) = 18.286(1) \text{ \AA}$ ,  $c = 20.208(2) \text{ \AA}$

【0012】

このMCM-68は、以下の組成式で表される。



(式中、 $n$ は7~12を表す。)

$Si/Al$ は約8.3~15である。

また、X線回折データは以下の値を含む。

2θ = 6.56 ± 0.10、6.88 ± 0.10、8.16 ± 0.10、8.80 ± 0.10、9.70 ± 0.10、19.50 ± 0.10、21.76 ± 0.10、22.56 ± 0.10、23.10 ± 0.10

10

【0013】

本発明の結晶性多孔質シリケートは、(1)シリカ、(2) N, N, N', N' - テトラアルキルピシクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2, 3:5, 6-ジピロリジニウムジヒドロキシド、及び(3) NaOHと水との混合物を乾燥して、粉末状のドライゲルとするドライゲル化工程、得られた該ドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触させた状態で反応させる重合工程、及び得られた結晶性シリケートに、更に、シリル化剤を加えてオートクレーブ中で加熱するシリル化工程、及びこれを焼成する焼成工程から成る。

以下、各工程を順を追って説明する。

【0014】

20

(1)ドライゲル化工程：

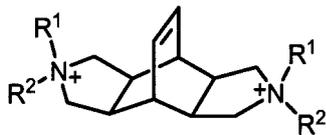
この工程では、シリカ源を含む原料を混合してドライゲルを用意する。

本発明で用いるシリカ源として、水ガラス、コロイダルシリカ、フュームドシリカ、シリコンアルコキシド、石英など、好ましくはフュームドシリカが挙げられる。

【0015】

本発明で用いる鑄型(テンプレート)は、下式

【化1】



30

で表される N, N, N', N' - テトラアルキルピシクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2, 3:5, 6-ジピロリジニウムであり、この化合物は二価陽イオンである。

式中のアルキル基(即ち、 $R^1$ 及び $R^2$ )は、同じであっても異なってもよく、その炭素数は1~4である。 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ、同じであってもよく、また全てのアルキル基(即ち、 $R^1$ 及び $R^2$ )が同じであってもよい。

このアルキル基としては、例えば、 $CH_3-$ 、 $CH_3CH_2-$ 、 $CH_3CH_2CH_2-$ 、 $(CH_3)_2CH-$ 、 $CH_3CH_2CH_2CH_2-$ 、 $(CH_3)_2CHCH_2-$ 、 $(CH_3CH_2(CH_3)CH-$ 、 $(CH_3)_3C-$ を挙げることができる、

このドライゲル化工程においては、この化合物(鑄型)の水酸化物又はハロゲン化物(ヨウ化物、臭化物、塩化物、フッ化物)、好ましくは水酸化物を用いる。

40

【0016】

本発明で用いるアルカリ金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物として、好ましくはアルカリ金属水酸化物であり、例えば、 $LiOH$ 、 $NaOH$ 、 $KOH$ 、 $CsOH$ 、 $Mg(OH)_2$ 、 $Ca(OH)_2$ 、 $Sr(OH)_2$ 又は $Ba(OH)_2$ 、好ましくは $NaOH$ が挙げられる。 $KOH$ の場合は純度85%以上、その他の場合は95%以上のものを使用し、脱イオン水で5~50%に希釈して用いるか、又は予め希釈されたものを使用する。

用いる水は高純度の水、例えば、イオン交換水(脱イオン水)が好ましい。

【0017】

以上の各成分を、シリカ100モルに対して、鑄型を10~50モル、より好ましくは

50

10 ~ 30 モル、NaOH を 1 ~ 30 モル、より好ましくは 10 ~ 30 モル、水を 500 ~ 10000 モル、より好ましくは 2000 ~ 7000 モルの割合で用いる。

これら原料を適宜混合し、攪拌して均一な水性反応原料組成物とした後、乾燥してドライゲルを作る。乾燥は、好ましくは 40 ~ 100、より好ましくは 60 ~ 95 で加熱して、全体が粉末状のドライゲルになるまで行なう。加熱時間は一般に 0.5 ~ 10 時間、より好ましくは 1 ~ 5 時間である。

#### 【0018】

##### (2) 重合工程

この工程では、上記で得られた粉末状のドライゲルを、飽和蒸気圧の水蒸気と接触させた状態で反応させて、結晶性シリケートを合成する。一般的には、100 ~ 200、好ましくは 150 ~ 180 に加熱し、3 時間 ~ 10 日程度、好ましくは 20 時間 ~ 3 日程度反応させると、目的の結晶性多孔質シリケートゼオライトが得られる。粉末状のドライゲルを飽和蒸気圧の水蒸気と接触状態で反応させるには、例えば、密閉型の反応器中に適当な容器に入れたドライゲルを置き、反応器中には水を用意した上で加熱して、飽和蒸気圧の水蒸気雰囲気中で反応させることによって行なうことができる。

10

#### 【0019】

この工程で得られる合成したままの (as-synthesized) 結晶性多孔質シリケートは、以下の組成式で表される。



式中、n は 0 ~ 12、m は 0 ~ n の整数を表し、R は上記の鑄型の陽イオン部分 (R<sup>2+</sup>) から電荷を除いたものを表す。

20

また、X 線回折データは以下の値を含む。

2 (単位: 度) = 6.88 ± 0.10、8.16 ± 0.10、8.84 ± 0.10、9.72 ± 0.10、19.48 ± 0.10、21.82 ± 0.10、22.70 ± 0.10、23.24 ± 0.10、ただし、2 = 23.24 ± 0.10 のピークの半値幅は 0.20 度以下である。

#### 【0020】

##### (3) シリル化工程

この工程では、得られた結晶性多孔質シリケートゼオライトに、シリル化剤を加えてオートクレーブ中で加熱する。上記で得られた結晶性シリケートには多数の Si の欠損があるため、そのまま焼成するとその欠損のため、結晶を維持することができない (比較例 1 参照)。そのため、この欠損部をシリカで埋めるために、当該シリル化工程が必要となる。

30

用いるシリル化剤は、一般式 SiZ<sub>4</sub> (式中、Z は、同じであっても異なってもよく、アルコキシ基、アルキル基又はハロゲン原子を表す。) で表される。このシリル化剤として、例えば、メチルトリエトキシシラン (Si(OEt)<sub>3</sub>Me)、メチルトリメトキシシラン (Si(OMe)<sub>3</sub>Me)、メチルクロロシラン (SiCl<sub>3</sub>Me)、ジクロロジメチルシラン (SiCl<sub>2</sub>Me<sub>2</sub>)、ジエトキシジメチルシラン (Si(OEt)<sub>2</sub>Me<sub>2</sub>) が挙げられ、好ましくはテトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン又はテトラクロロシランである。

本工程においては、上記で得られた結晶性シリケートにこのシリル化剤を加えて、オートクレーブ中、120 ~ 200 で、0.5 ~ 7 日間加熱する

40

#### 【0021】

##### (4) 焼成工程

この結晶性シリケートを、オートクレーブから取り出した後焼成する。この焼成は、通常、マッフル炉又は管状炉を用いて、O<sub>2</sub> : N<sub>2</sub> = 0 : 100 ~ 100 : 0 の雰囲気中、0.1 ~ 100 ml / 分の流量で 1 ~ 12 時間流通させて行う。

#### 【0022】

この工程で得られる結晶性多孔質シリケートゼオライトは、以下の組成式で表される。

式 Si<sub>112-n</sub> O<sub>224-m</sub> H<sub>4n-2m</sub> (式中、n は 0 ~ 12、m は 0 ~ n の整数を表す。)

50

また、X線回折データは以下の値を含む。

2θ (単位：度) = 6.52 ± 0.10、6.84 ± 0.10、8.12 ± 0.10、8.80 ± 0.10、9.68 ± 0.10、19.44 ± 0.10、21.76 ± 0.10、22.64 ± 0.10、23.16 ± 0.10、ただし、2θ = 23.16 ± 0.10のピークの半値幅は0.20度以下である。

この結晶性多孔質シリケートは、上述のMCM-68構造を持ち、上記表1の空間群と原子座標で特定される骨格トポロジを有する。

#### 【0023】

なお、上記重合工程で得られた合成したままの(as-synthesized)結晶性多孔質シリケートをそのまま焼成すると結晶を維持することができない(比較例1参照)ことから分かるように、合成したままの結晶性多孔質シリケートはゼオライトMCM-68のトポロジーの多数のSiが欠損しているものと考えられる。本発明においては、この欠損部をシリカで埋めるために、上記シリル化工程を行っているが、その条件によっては欠損部の全てを埋めることができない場合もある。従って、本発明で得られる焼成後の結晶性多孔質シリケートは、この欠損部が全て埋まったもの(n=m=0)及びその一部が欠損したもの(0<n<12, 0<m<12)も含む。最も欠損が多かった場合(n=m=12)には、欠損がない場合と比較して重量が7.5%減少する。予想される欠損部位は、図1において矢印で示したSiである。ただし、いずれの場合に於ても、本発明の結晶性多孔質シリケートの基本骨格がMCM-68トポロジーであることには変わりがない。

#### 【0024】

このようにして得られた結晶性多孔質シリケートは、MCM-68の骨格をもつ各種メタロシリケートの基盤材料(前駆体)として有用である。また、吸着能力に優れるため、環境汚染物質である揮発性有機化合物(VOC)などの吸着剤、脱臭剤などとして有用性をもつと期待される。

#### 【実施例】

#### 【0025】

以下、実施例にて本発明を例証するが本発明を限定することを意図するものではない。本実施例において、窒素吸着は以下の条件で測定した。

使用装置：日本ベル社製Belsorp 28SA 全自動吸着測定装置

測定温度：-196

空気恒温槽温度：40

平衡吸着時間：300秒

サンプル前処理条件：400℃、2時間

またX線回折は以下の条件で測定した。

使用装置：MAC Science社製MX-Labo粉末X線解析装置

X線源：CuKα = 1.5405Å、印加電圧：40 kV、管電流：20 mA

測定範囲：2θ = 2.040 ~ 52.000deg

スキャン速度：2.000 deg./min、サンプリング間隔：0.040 deg.

発散スリット：1.00 deg、散乱スリット：1.00 deg、受光スリット：0.30 mm

縦型ゴニオメータ、モノクロメータ使用

測定方法 連続法、通常法

格子面間隔dはオングストローム単位であり、ピークの相対強度I/I<sub>0</sub>は、最も強いピークの強度をI<sub>0</sub>として、それぞれのピークをその百分率で表したものであり、プロフィール適合ルーチン(又は二次導関数アルゴリズム)の使用により導いた。それらの強度は、ローレンツ効果及び偏光効果について補正は行っていない。

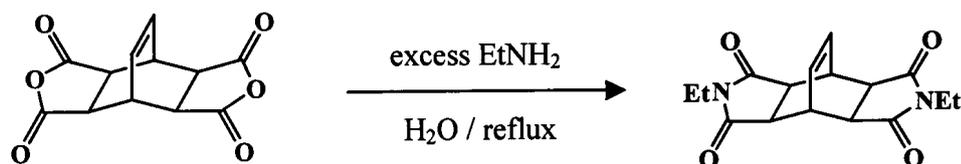
#### 【0026】

#### 製造例1

本合成例では、後記の実施例で用いる鑄型を合成した。

まず、下式で示すようにN,N'-ジエチルピシクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-テトラカルボキシジイミドを合成した。

## 【化2】

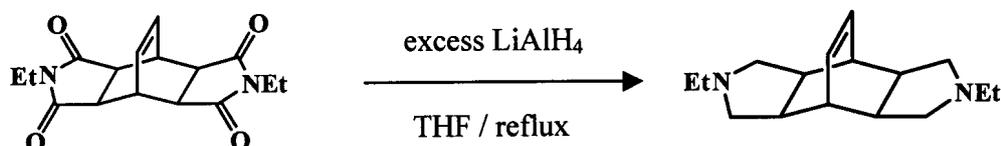


ビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-テトラカルボン酸二無水物(アルドリッチ製) 15.7 g (63 mmol)を500 ml二口フラスコに入れ、続いてエチルアミン(関東化学)(70wt% in water) 100 ml (1.26 mol)を加えて室温で2時間攪拌した。ここに蒸留水(46 ml)を加え、その後還流し、70 で24時間、次いで100 で20時間攪拌した。放冷後、濃塩酸(1 ml)をpHが約2になるまでゆっくり滴下した。これをプフナーロートを用いて吸引濾過し、洗液のpHがほぼ中性になるまで蒸留水(500 ml)で洗浄して得られた固体を40 で乾燥した。生成物(N,N'-ジエチルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-テトラカルボキシジイミド)の収量は17.1 g(収率 90%)であった。

## 【0027】

次に、N,N'-ジエチルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジンを合成した。

## 【化3】

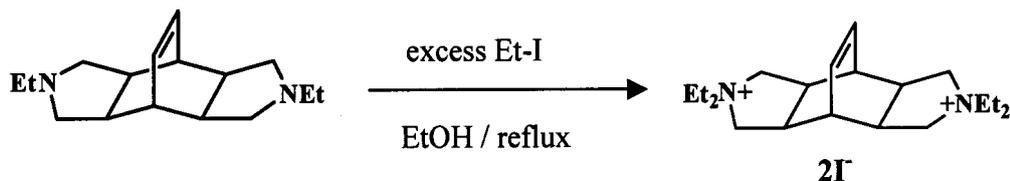


N<sub>2</sub>雰囲気、1000 ml 二口フラスコに水素化リチウムアルミニウム(LiAlH<sub>4</sub>、和光純薬製) 6.2 g (164 mmol)を入れ、続いてテトラヒドロフラン(THF) 300 mlを加えながら還流し、攪拌を開始した。ここに上記で得たジイミド16.0 g (53 mmol)を少しずつ加え、THF (240 ml)で洗い入れた。その後68時間還流下攪拌した。放冷後、過剰のLiAlH<sub>4</sub>を分解するために、よく攪拌しながら蒸留水(6.2 g)、15wt% NaOH (6.2 g)、蒸留水(18.7 g)を約30分間隔で順次ゆっくり加え、加え終わってから2時間攪拌した。次にガラスフィルター(G3)を用いて吸引濾過後、フィルター上の固形物をTHF (120 mL)でよく洗浄し、濾液と洗液を合わせて減圧濃縮した。得られた油状物質から水分を完全に除去し、油状の生成物(N,N'-ジエチルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジン)を得た。収量は12.1 g(収率 93%)であった。

## 【0028】

次に、N,N,N',N'-テトラエチルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジピロリジニウム二ヨウ化物を合成した。

## 【化4】



上記で合成したジピロリジン12.1 g (49 mmol)をエタノール(EtOH) 90 mLに溶解し、攪拌しつつヨウ化エチル(EtI) 17 ml (212 mmol)を滴下口より滴下した。滴下終了後、内壁に付着したヨウ化エチルをEtOH (50 ml)とともに反応液に加え、系内を無水状態に保ちつつ157時間還流下攪拌した。放冷後、アセトン100 mlを加え、これをガラスフィルター(G3)で吸引濾過して結晶生成物を得た。この結晶生成物をアセトン約80 mlずつを用いて二度加熱洗浄して放冷後、アセトン(50 mL)及びベンゼン(40 ml)で順次洗浄し、真空乾燥した。生成物(N,N,N',N'-テトラエチルビスクロ[2.2.2]オクト-7-エン-2,3:5,6-ジ



、イオン交換水で洗浄後室温で乾燥して淡褐色粉末670 mgを得た。

【0032】

次に、上記で得たままの結晶200 mgを内容積23 mlのオートクレーブに入れ、続いて、1 M HNO<sub>3</sub> 6.0 g、テトラエチルオルトシリケート(TEOS) (キシダ化学製) 30 mgを加え、150、48時間、回転下(20 rpm)で処理を行った。その後、サンプルは濾過し、濾過されてくる濾液が中性になるまで蒸留水で洗浄し、80 のオーブンで乾燥して薄黄色粉末結晶180 mgを得た。得られた結晶10.0 mgをアルミナ製のシャーレに入れ、マッフル炉を用いて空気雰囲気下室温より120 まで50分間で昇温、120 で2時間保持し、その後2 /分で500 まで昇温、500 で3時間保持した。放冷して焼成済み(calcined)サンプルの結晶(白色粉末、9.1 mg)を得た。

10

【0033】

得られた結晶のX線回折パターンを図2に示す。(1)はドライゲル化後の本発明のシリケート、(2)はMCM-68(参考例1)を示す。(1)と(2)は同等のX線パターンを示している。また、(2)よりも(1)の方が明らかに線幅が狭く、(1)の方が結晶性が高いことを示している。

【0034】

また、得られた結晶のX線回折結果を下表に示す。

ドライゲル化後及びシリル化後ともに、MCM-68(比較例1)と類似のX線回折パターンが得られているが、シリル化後の方がよりMCM-68に近い。

【表2】

20

ドライゲル化後			シリル化後			MCM-68(参考例1)		
2Theta	d	I/Io	2Theta	d	I/Io	2Theta	d	I/Io
6.92	12.7632	15	6.56	13.4626	51	6.56	13.4626	63
8.20	10.7735	21	6.88	12.8370	62	6.88	12.8370	78
8.88	9.9503	18	8.16	10.8260	45	8.16	10.8260	45
9.76	9.0547	27	8.80	10.0402	51	8.80	10.0402	46
10.92	8.0952	7	9.72	9.0917	76	9.68	9.1291	82
13.16	6.7222	10	10.88	8.1248	30	10.84	8.1546	32
15.40	5.7491	10	13.72	6.4487	28	13.72	6.4487	27
18.12	4.8917	8	14.96	5.9172	19	14.84	5.9645	15
19.52	4.5438	29	17.56	5.0464	23	17.52	5.0579	15
20.12	4.4098	11	19.48	4.5531	46	19.44	4.5625	40
20.72	4.2834	17	20.08	4.4183	50	20.04	4.4271	31
21.20	4.1874	8	20.64	4.2998	29	20.60	4.3079	17
21.84	4.0662	100	21.20	4.1874	30	21.08	4.2111	14
22.76	3.9038	28	21.80	4.0735	100	21.76	4.0810	100
23.28	3.8178	57	22.68	3.9174	70	22.56	3.9379	52
26.36	3.3783	9	23.20	3.8307	77	23.12	3.8438	72
27.16	3.2805	9	26.32	3.3833	34	26.24	3.3934	27
27.72	3.2155	33	27.64	3.2247	51	26.96	3.3045	18
28.44	3.1358	23	28.32	3.1487	30	27.60	3.2292	41
29.44	3.0315	11	30.96	2.8860	32	28.24	3.1575	19
30.52	2.9266	10	33.48	2.6743	21	29.32	3.0436	19
31.08	2.8751	14	35.96	2.4954	18	30.32	2.9454	19
33.60	2.6650	10	42.04	2.1474	15	30.92	2.8897	22
36.48	2.4610	8	45.08	2.0094	18	33.40	2.6805	14
45.24	2.0027	6	47.96	1.8953	16	35.80	2.5061	10
48.00	1.8938	6	49.96	1.8240	20	41.88	2.1553	8
50.08	1.8199	7				45.00	2.0128	10
						47.80	1.9013	9
						49.84	1.8281	12

30

40

【0035】

ドライゲル化後(本発明の結晶性多孔質シリケートのas-synthesizedサンプル)及びMC

50

M-68 (比較例 1) の結晶の走査型電子顕微鏡写真を図 3 に示す。いずれのサンプルも直方状の結晶形態 (モルフォロジー) を有しているが、比較例 1 の MCM-68 の粒子径は  $0.1 \mu\text{m}$  以下と非常に小さく、ろ過に困難を伴う場合がある。これに対し、本発明のシリケートは粒子径が  $0.5 \sim 1 \mu\text{m}$  であり、触媒材料、吸着材料として適度な大きさと形状を持っている。

#### 【0036】

また、それぞれのサンプルを  $400^\circ\text{C}$  で 2 時間真空排気し、表面に吸着している水分などを除去した後、サンプルを大気に触れさせること無く自動吸着測定装置に装着し、窒素ガスの吸着を容量法を用いて液体窒素温度 ( $-196^\circ\text{C}$ ) で測定した。吸着等温線を図 4 に示す。

(1) は本発明の結晶性多孔質シリケート、(2) は MCM-68 (参考例 1) を示す。

いずれのサンプルも、相対圧 (横軸) が 0.2 以下の領域で急激な立ち上がりが見られ、両者ともほぼ同等であった。このことから、シリル化によって細孔容積の大きな低下は見られず、シリル化で細孔が塞がっていないことがわかる。

またこの吸着等温線は、本発明の結晶性多孔質シリケート (1) は MCM-68 (2) より窒素の吸着量が大きく、優れた吸着剤であることを示している。

#### 【0037】

##### 比較例 1

実施例 1 と同様に、製造例 3 で得た N, N, N', N'-テトラエチルビスクロ[2, 2, 2]オクト-7-エン-2, 3:5, 6-ジピロリジニウムジヒドロキシド水溶液 ( $0.480 \text{ mmol/g}$ )  $2.08\text{g}$  ( $1.0 \text{ mmol}$ )、NaOH ( $6.32 \text{ mmol/g}$ )  $238 \text{ mg}$  ( $1.5 \text{ mmol}$ ) をフッ素樹脂製ジャーに量り取り、30 分間攪拌。これにフュームドシリカ (Cabot 製 Cab-O-Sil)  $601 \text{ mg}$  ( $10 \text{ mmol}$ ) を加え、3 時間攪拌した。その後  $80^\circ\text{C}$  で攪拌を続け、ゲルの粘土が上がってきたらフッ素樹脂製の棒で攪拌し、全体がドライゲルになるまでこれを続けた。これにより粉末状としたドライゲルを得た。

次にこの粉末状のドライゲルをフッ素樹脂製カップ (内径  $21 \text{ mm}$ , 高さ  $26 \text{ mm}$ ) に移し、このフッ素樹脂製カップを水 ( $0.2 \text{ g}$ ) の入った内容積  $23 \text{ ml}$  のオートクレーブ中に置いた。このオートクレーブを  $150^\circ\text{C}$  で 5 日間静置した。生成した固体を濾過装置に移し、イオン交換水で洗浄後室温で乾燥して淡褐色粉末  $670 \text{ mg}$  を得た。

次に、上記で得たままの結晶  $5.0 \text{ mg}$  をアルミナ製のシャーレに入れ、マッフル炉を用いて空気雰囲気下で室温から  $2^\circ\text{C}/\text{分}$  で  $450^\circ\text{C}$  まで昇温し、 $450^\circ\text{C}$  で 2 時間保持した。放冷して calcined の結晶 (白色粉末、 $3.6 \text{ mg}$ ) を得た。X 線回折分析を行ったが、ピークは得られなかった。結晶が加熱によって崩壊したものと考えられる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0038】

【図 1】本発明の結晶性多孔質シリケートの骨格トポロジーを示す図である。

【図 2】本発明の結晶性多孔質シリケート X 線回折パターンを示す図である。(1) はドライゲル化後の本発明のシリケート、(2) は MCM-68 (参考例 1) を示す。個々のピークの強度がサンプルによって異なるのは、結晶の晶癖によって配向性が異なるためと考えられる。

【図 3】本発明の結晶性多孔質シリケートの走査型電子顕微鏡写真を示す図である。(1) はドライゲル化後の本発明のシリケート、(2) は MCM-68 (参考例 1) を示す。背景はサンプルを保持するための銅のメッシュである。

【図 4】本発明の結晶性多孔質シリケートの窒素吸着等温線を示す図である。(1) はドライゲル化後の本発明のシリケート、(2) は MCM-68 (参考例 1) を示す。

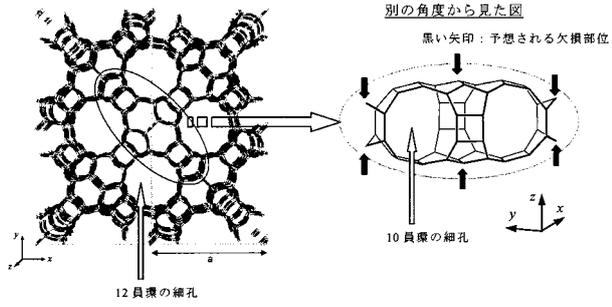
10

20

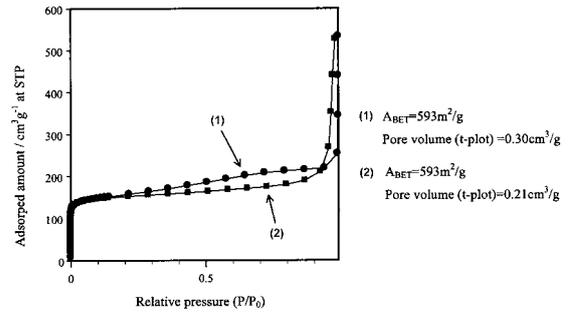
30

40

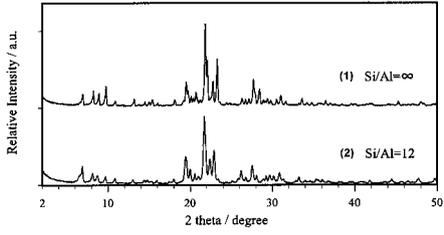
【 図 1 】



【 図 4 】

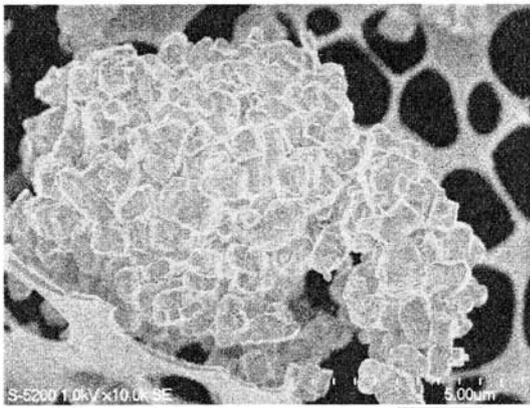


【 図 2 】



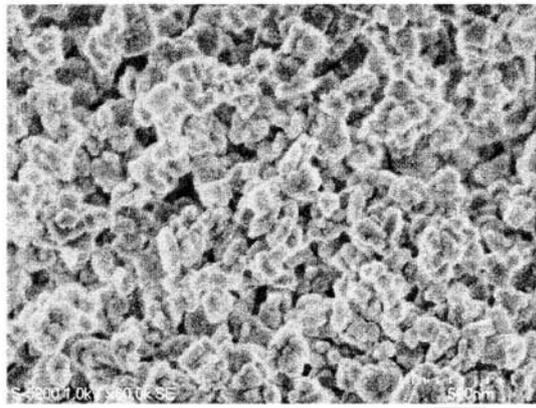
【 図 3 】

(1)



2 μm

(2)



0.2 μm

---

フロントページの続き

(72)発明者 小山 啓人

神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79番1号 国立大学法人横浜国立大学内

Fターム(参考) 4G073 AA03 BA02 BA63 BA75 BB02 BB44 BB48 BB58 BC02 BD11  
CZ54 FB12 FB41 FC18 FD01 FD21 FD24 FD30 FE05 FE20  
GA01 GA03 GA12 GA13 GB02 GB03 UA03